## PATENT COOPERATION TREATY

# TRANSLATION INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

	d's or ag	ent's file referer 10	nce	FOR FURTHER A	CTION	See Form PCT/IPEA/416
Internation	onal app	lication No.		International filing da	te (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT	<b>JP2</b>	005/000	226	12.01.200	5	29.03.2004
Internation	onal Pat	ent Classification	n (IPC) or natio	onal classification and	IPC	
	L21/		•	•		
Applicar	ıt					
NEC	COR	PORATIO	N			
1.	under A	Article 35 and tr	ansmitted to th	e applicant according to		nternational Preliminary Examining Authority
2.	This R	EPORT consists	s of a total of _	5	sheets, including	this cover sheet.
3.	This re	port is also acco	mpanied by Al	NNEXES, comprising:		
	a 🗵	(sent to the	applicant and	to the International Bu	reau) a total of 2	sheets, as follows:
		sheet	s of the descrip	tion, claims and/or dra	wings which have been a	mended and are the basis for this report and/or
			s containing reductions).	ctifications authorized	by this Authority (see Rul	le 70.16 and Section 607 of the Administrative
		the d	s which supers isclosure in the	ede earlier sheets, but international applicat	which this Authority cons ion as filed, as indicated	siders contain an amendment that goes beyond in item 4 of Box No. I and the Supplemental
	_	Box.				
	ъ	(sent to the	International	Bureau only) a total of	(indicate type and number	r of electronic carrier(s))
						, containing a sequence listing and/or tables
				readable form only, a rative Instructions).	s indicated in the Supple	mental Box Relating to Sequence Listing (see
4.	This re	port contains in	dications relati	ng to the following iter	ns:	
	$\boxtimes$	Box No. I	Basis of the	report		
ŀ		Box No. II	Priority	•		•
		Box No. 111	Non-establi	shment of opinion with	regard to novelty, invent	ive step and industrial applicability
		Box No. IV	Lack of uni	ty of invention		
	$\boxtimes$	Box No. V		tatement under Article d explanations support		lty, inventive step or industrial applicability;
	$\boxtimes$	Box No. VI	Certain doc	uments cited		
	$\boxtimes$	Box No. VII	Certain defe	ects in the international	application	•
		Box No. VIII	Certain obs	ervations on the interna	ational application	
Date of	submiss	ion of the dema	nd		Date of completion of th	is report
						•
Name 2	nd maili	ng address of th	e IPEA/JP		Authorized officer	
		o. Hi	•			
F	1 37.				Telephone No	

International application No.
PCT/JP2005/000226

Box	No. I	Basis of the report		•
1.		d to the language, this report is based on the internation	nal application in the language in which i	it was filed, unless otherwise
		report is based on translations from the original langua		,
	.— which	h is the language of a translation furnished for the purp	ooses of:	
	片	international search (Rule 12.3 and 23.1(b))		
	H	publication of the international application (Rule 12.4		
2.	With regard	international preliminary examination (Rule 55.2 and d to the elements of the international application, this		which have been furnished to the
~	receiving (	Office in response to an invitation under Article 14 at	re referred to in this report as "original	ly filed" and are not annexed to
		ternational application as originally filed/furnished		
	$\overline{\square}$	escription:		
	pages			as originally filed/furnished
	page		received by this Authority on	
	. page:			
	_	laims:		as originally filed/furnished
İ	nos.	2-4,6-9	as amonded (together with	any statement) under Article 19
	nos.*		received by this Authority on	
	nos.*			, -
	nos.*			
	<u> </u>	rawings:	•	
	sheet			as originally filed/furnished
	sheet		-	
	sheet		•	
l	L a seq	uence listing and/or any related table(s) - see Supplen	nental Box Relating to Sequence Listing.	•
3.	The	amendments have resulted in the cancellation of:		
	닐	the description, pages		<del> </del>
	$\boxtimes$	the claims, nos. 5,10		<del></del> .
		the drawings, sheets/figs		
		the sequence listing (specify):		
		any table(s) related to sequence listing (specify):		
4.	This they	report has been established as if (some of) the amen have been considered to go beyond the disclosure as t	iled, as indicated in the Supplemental Bo	below had not been made, since x (Rule 70.2(c)).
		the description, pages		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		the drawings, sheets/figs		
		the sequence listing (specify):		
		any table(s) related to sequence listing (specify):		
*	If item 4 a	pplies, some or all of those sheets may be marked "suj	perseded."	

International application No.
PCT/JP2005/000226

Box			ticle 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; porting such statement	
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-4, 6-9, 11-12	YES
		Claims		_ NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-4, 6-9, 11-12	YES
	•	Claims		_ NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-4, 6-9, 11-12	YES
	•	Claims		_ NO
1				

- 2. Citations and explanations (Rule 70.7)
  - Document 1: JP 2002-057186 A (Victor Company of Japan, Ltd.), 22 February 2002, entire text; [fig. 1] to [fig. 4]
  - Document 2: JP 2003-179100 A (NEC Corporation), 27 June 2003, paragraph [0040]
  - Document 3: JP 2002-343829 A (NEC Corporation), 29

    November 2002, paragraph [0037]
  - Document 4: JP 2000-138255 A (NEC Corporation), 16 May 2000, claim 2

The semiconductor device having a chain structure set forth in claims 1 to 4 is neither disclosed nor suggested in any of the documents cited in the international search report.

The process for manufacturing a semiconductor device, which contains the steps disclosed in claims 6 to 9, 11 and 12, is neither disclosed nor suggested in any of the documents cited in the international search report.

International application No.
PCT/JP2005/000226

Certain p	oublished documents (I				
	Application 1 Patent No.		Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid clain (day/month/year)
J	2004-103	928 A	02.04.2004	11.09.2002	
[]	E,X]				
				* .	
			•		
					•
				,	
			.*• 	•	
				,	
Non-wri	iten disclosures (Rule	70.9)	···		
Non-wri	itten disclosures (Rule Kind of non-writte		Date of non-written	disclosure referr	Date of written disclosure ing to non-written disclosure
Non-wri			Date of non-written (day/month/ye	disclosure referr	Date of written disclosure ing to non-written disclosure (day/month/year)
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri				disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri		n disclosure		disclosure referr	ing to non-written disclosure
	Kind of non-writte	n disclosure	(day/month/ye	disclosure referr	ing to non-written disclosure
Non-wri	Kind of non-writte	n disclosure	(day/month/ye	disclosure referr	ing to non-written disclosure

International application No.
PCT/JP2005/000226

Box No. VII Certain defects in the international application
The following defects in the form or contents of the international application have been noted:
The wording " $\square\square$ $\square$ " disclosed on page 4, line 14 is
understood to be a typographical error for " $\Box\Box\Box\Box\Box$ ".
·
·
~
·
<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I '

# 特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人   の書類記号 04NPCT010	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2005/000226	国際出願日 (日. 月. 年) 12. 01. 2005 優先日 (日. 月. 年) 29. 03. 2004					
国際特許分類(I P C) Int.Cl. H01L21/60(2006. 01)						
出願人(氏名又注名称) 日本電気株式会社						
法施行規則第57条 (PCT36条)の 2. この国際予備審査報告は、この表紙を 3. この報告には次の附属物件も添付され a. 図 附属書類は全部で 2	を含めて全部で 5 ページからなる。  れている。 ページである。  遊とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細費、請求の範PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照) したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの					
第1V欄 発明の単一性の	最告の基礎 E又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 D欠如 に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 大及び説明 C献					
国際予備審査の請求書を受理した日 18.01.2006	国際予備審査報告を作成した日 08.05.2006					
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100 8915 東京都千代田区園が関三丁月43						

東京都千代田区霞が関三丁月4番3号 様式PCT/IPEA/409(表紙) (2005年4月)

第I	棚	報告の基礎
1 3	主語:	に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
		出願時の言語による国際出願
		出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
		国際公開(PCT規則12.4(a))
	1	国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))
		報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	П	出願時の国際出願書類
	V	明細書
		第 1 - 2 2 ページ、出願時に提出されたもの
		第       ページ*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	請求の範囲
		第 2-4,6-9 項、出願時に提出されたもの
		第1,11,12       項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの         第       内けで国際予備審査機関が受理したもの
		第
	V	図面
	5.T. /	
		第       ページ/図 、 出願時に提出されたもの         第       ページ/図 * 、 付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ/図 * 、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 付けで国際予備審査機関が受埋したもの
		配列表乂は関連するテーブル
		配列表に関する補充欄を参照すること。
	·	(キャンシトの) エフュッカギスは地域を含むる
3.	<b>*</b>	補正により、下記の書類が削除された。
		明細書 第ページ
		対抗性   第
		配列表 (具体的に記載すること)
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
		えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		<b>Ⅲ</b> 明細書 第 <u> </u>
1		請求の範囲 第
1		図面
	, ,	こ該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。
<u> </u>	z. 1	CBN 17 W W II C COMMING CAPOLOGICA C BB/ 3C 40 0 C C A V/ NO

第V	7欄 新規性、進歩性又は産業上 それを裏付ける文献及び説	の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、 明	
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-4,6-9,11-12</u> 請求の範囲	一 <sup>有</sup> 一 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 1-4,6-9,11-12 請求の範囲	_ 有 _ 無
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-4,6-9,11-12 請求の範囲	一 有 _ 無
2.	文献 1: JP 2002-057 全文, 【図 文献 2: JP 2003-179 文献 3: JP 2002-343	0.7) [186 A(日本アビオニクス株式会社)2002.02.22, [1] -【図4】 [100 A(日本電気株式会社)2003.06.27, 【0040】 [829 A(日本電気株式会社)2002.11.29, 【0037】 [8255 A(日本電気株式会社)2000.05.16, 請求項2	

請求の範囲1-4に開示された一連の構造を有する半導体装置は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載も示唆もされていない。

請求の範囲 6-9, 11-12 に開示されている工程を経る半導体装置の製造方法は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載も示唆もされていない。

<b>特許性</b>	i B.S -i	· ス宝	際予	借却	牛

国際出願番号 PCT/JP2005/000226

IVI欄 ある種の引用文献	ر		
. ある種の公表された文書(PCT	「規則 70. 10)		
出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日(有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2004-103928 A	02. 04. 2004	11. 09. 2002	
ſE, XJ			
		,	
		•	
•			
キート・1 RR こいが の明 この経営	事子な トッ 服二さん の態	ラーカロ ・ 東西に	トス関ラリ外の関元に言及してい.
書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の併 (日.月.年)	帯示の日付 書面によ	よる開示以外の開示に言及している 書面の日付(日.月.年)
書面による開示以外の開示の種類		引示の日付 書面に。 	
書面による閒示以外の閒示の種類		引示の日付 書面に。 	
書面による開示以外の開示の種類		引示の日付 書面に。 	
書面による開示以外の開示の種類		引示の日付 書面に。 	
書面による開示以外の開示の種類		開示の日付 書面に。 	
書面による開示以外の開示の種類		開示の日付 書面に。 	
書面による開示以外の開示の種類		引示の日付 書面に	
書面による開示以外の開示の種類		明示の日付 書面に。 	
書面による開示以外の開示の種類	(日. 月. 年)	書面に	書面の日付(日、月、年)
書面による開示以外の開示の種類			書面の日付(日、月、年)
書面による開示以外の開示の種類	(日. 月. 年)		書面の日付(日、月、年)
	(日. 月. 年)		書面の日付(日、月、年)
	(日. 月. 年)		書面の日付(日、月、年)

4頁第14行に記載された「りフロー」	は「リフロー」の誤記である。	
·		
	·	
	·	
•		
•		

### 請求の範囲

- [1] (補正後)その表面に電極パッドが形成された配線基板と、この配線基板上に配置されその表面に電極が形成された半導体素子と、前記電極を前記電極パッドに接続するはんだにより形成されたパンプと、前記配線基板と前記半導体素子との間に充填され前記パンプを埋め込むアンダーフィル樹脂と、を有し、前記配線基板は前記電極パッドが形成されている側の表面に配置されたソルダーレジストを有し、このソルダーレジストには前記電極パッドを酵出させる開口部が形成されており、前記配線基板と前記半導体素子との間において、前記電極パッドの直上域を除く領域における前記ソルダーレジストの厚きが、前記領域における前記ソルダーレジストの厚きが、前記領域における前記ソルダーレジスト上に配置された前記アンダーフィル樹脂の厚さ以上であることを特徴とする半導体装置。
- [2] 前記ソルダーレジスト上に配置された前記アンダーフィル樹脂の厚さが50 μ m以下であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。
- [3] 前記パンプの体積は前記開口部の容積よりも小さいことを特徴とする請求項1又は2 に記載の半導体装置。
- [4] 前記ソルダーレジストの厚さが30 μ m以上であることを特徴とする請求項3に記載の 半導体装置。
- [5] (削除)
- [6] その表面に電極パッドが形成された配線基板及びその表面に電極が形成された半導体素子を備え、前記配線基板は前記電極パッドが形成された側の表面に配置され前記電極パッドを露出させる開口部が形成されたソルダーレジストを備えた半導体装置の製造方法において、前記電極パッド上及び前記電極上のうち少なくとも方にバンプを形成する工程と、前記配線基板上における前記半導体素子が搭載される予定の領域の少なくとも一部に液体状の樹脂材料を被着させる工程と、前記半導体素子を前記配線基板に押し付けて前記電極パッド、前記パンプ及び前記電極を相互に接続する工程と、前記パンプを溶融させた後凝固させて前記電極を前記パンプを介して前記電極パッドに接合する工程と、前記樹脂材料を硬化させて前記配線基板と前記半導体素子との間に前記パンプを埋め込むようにアンダーフィル樹脂を形

成する工程と、を有し、前記接合する工程において、前記パンプの溶融中に前記配 線基板と前記半導体素子との間の距離を制御し、前記アンダーフィル樹脂の形成後 において、前記配線基板と前記半導体素子との間において、前記電極パッドの直上 城を除く領域における前記ソルダーレジストの厚さを、前記領域における前記ソルダーレジスト上に配置された前記アンダーフィル樹脂の厚さ以上とすることを特徴とする 半導体装置の製造方法。

- [7] 前記パンプを形成する工程において、前記パンプの体積を、前記開口部の容積より も小さくすることを特徴とする請求項6に記載の半導体装置の製造方法。
- [8] 前記ソルダーレジストの厚さを30 μ m以上とすることを特徴とする請求項7に記載の 半導体装置の製造方法。
- [9] 前記接合する工程において、前記配線基板と前記半導体素子との間の距離の制御 は、前記配線基板に対する前記半導体素子の相対的な位置を制御することによって 行うことを特徴とする請求項6乃至8のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方 法。
- [10] (削除)
- [11] (補正後)前記樹脂材料には、酸化膜除去作用を持つ薬品が添加された樹脂材料を使用することを特徴とする請求項6乃至9のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法。
- [12] (補正後)前記バンプを形成する工程と前記樹脂材料を被着させる工程との間に、前記配線基板における前記電極パッドが形成されている側の表面及び前記半導体素子における前記電極が形成されている側の表面のうち少なくとも一方にプラズマ処理を施す工程を有することを特徴とする請求項6乃至9,11のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法。